

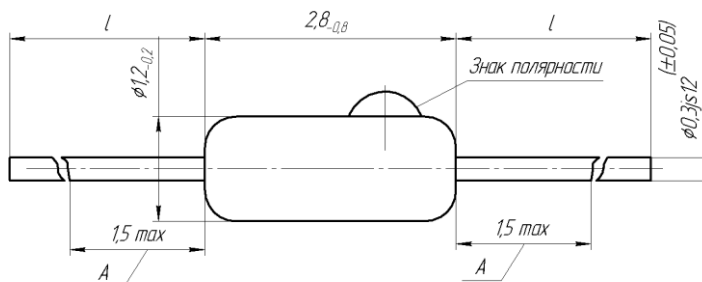
ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

Кремниевые эпитаксиально - планарные импульсные полупроводниковые диоды

**2Д520А,
2Д520А «ОС»**

аАО.339.163 ТУ, аАО.339.190 ТУ (для «ОС»)

Габаритный чертеж



1. А - длина выводов, непригодная для монтажа
2. Размер выводов в зоне А не регламентируется

Вид исполнения	l, мм
-	12±2
ОС	20±2

Принципиальная схема



Основные электрические параметры при $T_{окр.среды} = (25 \pm 10)^\circ C$

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма
Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, В	$U_{обр.мах}$	15
Максимально допустимое импульсное обратное напряжение, В	$U_{обр.и.мах}$	25
Максимально допустимый импульсный прямой ток, мА ($\tau_n \leq 10$ мкс, $Q \geq 2,5$)	$I_{пр.и.мах}$	50
Максимально допустимый постоянный прямой ток, мА	$I_{пр.мах}$	20

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма, не более	Режим измерения
Импульсное прямое напряжение, В	$U_{пр.и}$	2	$I_{пр.и} = 20$ мА
Постоянное прямое напряжение, В	$U_{пр}$	1	$I_{пр} = 20$ мА
Постоянный обратный ток, мкА	$I_{обр}$	1	$U_{обр.мах} = 15$ В
Общая емкость диода, пФ	C_d	3	$U_{обр} = 5$ В $f = 1 \div 10$ МГц
Заряд восстановления, пКл	$Q_{вос}$	100	при переключении с $I_{пр} = 10$ мА, на $U_{обр.и} = 10$ В